

B 340 D · B 341 D · B 342 D

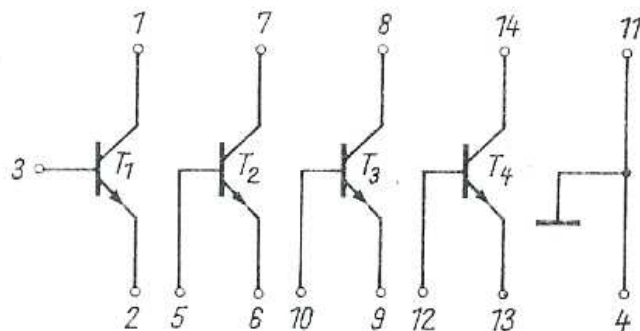
Integrierte Transistorarrays mit vier Si-npn-Transistoren

Bauform 5

Anschlußbelegung

1 Kollektor T1	8 Kollektor T3
2 Emitter T1	9 Emitter T3
3 Basis T1	10 Basis T3
4 Masse	11 Masse
5 Basis T2	12 Basis T4
6 Emitter T2	13 Emitter T4
7 Kollektor T2	14 Kollektor T4

Innere Schaltung



Grenzwerte gültig für den Betriebstemperaturbereich

Kollektor-Emitter-Spannung	U_{CEO}	15 V
Kollektor-Basis-Spannung	U_{CBO}	20 V
Emitter-Basis-Spannung	U_{EBO}	5 V
Kollektor-Substrat-Spannung	U_{C10}	30 V
Kollektorstrom	I_C	10 mA
Basisstrom	I_B	5 mA
Wärmewiderstand für Gesamt I_S	R_{thja}	120 K/W
Betriebstemperaturbereich	ϑ_a	-25 ... 85 °C
Sperrschichttemperatur	ϑ_j	125 °C

Kennwerte bei $\vartheta_a = 25 \text{ °C} \pm 5 \text{ K}$

Gleichstromverstärkung	$h_{21E(T1)}$	c 56 ... 140
$U_{CB} = 5 \text{ V}, I_E = 1 \text{ mA}$		d 112 ... 280
		e 224 ... 560

$U_{CB} = 5 \text{ V}, I_E = 10 \text{ }\mu\text{A}$	h_{21E}	c, d, e	30
Verhältnis der Gleichstromverstärkung für alle möglichen Transistorpaare			

$U_{CB} = 5 \text{ V}, I_E = 1 \text{ mA}$	$\frac{h_{21E(x)}}{h_{21E(y)}}$		0,8 ... 1,25
--	---------------------------------	--	--------------

Differenz der Basis-Emitter-Spannungen für alle möglichen Transistorpaare (nur B 340/341)			
$U_{CB} = 5 \text{ V}, I_E = 100 \text{ }\mu\text{A}$	U_B		$\leq 5 \text{ mV}$

$U_{CE} = 5 \text{ V}, I_C = 1 \text{ mA}, f = 100 \text{ MHz}$	f_T		135 MHz
---	-------	--	---------

Rauschfaktor für B 341 D			
$I_C = 200 \text{ }\mu\text{A}, f = 1 \text{ kHz}, \Delta f = 100 \text{ Hz}, R_G = 2 \text{ k}\Omega$			$\leq 6 \text{ dB}$